

第5回 荻田陽一郎 (神奈川工科大学)

期日： 2008年6月20日(金)午後～21日(土)

会場： 神奈川工科大学 情報学部棟 12F [メディアホール](#) (講演)、
6月20日(金曜日)

開始 終了 講演題目、発表者(○:登壇者)、所属

13:00 13:05 オープニング

セッション 20-1 座長：大平 圭介 (北陸先端科学技術大学院大学)

13:00 13:40 1. 化学気相堆積過程における、気相、表面反応 【招待講演】

○梅本 宏信 (静岡大学)

13:40 13:55 2. Cat-CVD 用触媒体材料の耐酸化特性

○工藤 嗣友、荻田 陽一郎 (神奈川工科大学)

13:55 14:10 3. Cat-CVD 用耐酸化キャタライザ材料の TMA 分解活性化エネルギー

○荻田 陽一郎、工藤 嗣友、岩井 諒平 (神奈川工科大学)

14:10 14:25 4. 加熱イリジウム触媒体上における酸化性分子分解過程

○梅本 宏信 1、草薙 弘樹 1、西村 和晃 2、牛島 満 2 (1 静岡大学、2 東京エレクトロン株式会社)

14:25 14:45 Coffee break

セッション 20-2 座長：和泉 亮 (九州工業大学)

14:45 15:15 5. フィルムベースエレクトロニクスのための薄膜技術 【招待講演】

○中山 弘 ((株) マテリアルデザインファクトリー&大阪市立大学)

15:15 15:30 6. Cat-CVD 法による超撥水 PTFE 膜を用いた新しいパターン化技術

○高地 道久、安岡 裕章、大平 圭介、松村 英樹、下田 達也 (北陸先端科学技術大学院大学)

15:30 15:45 7. HMDS を用いた Cat-CVD 法による SiO_xN_y ガスバリア膜の製膜速度の向上

○佐々木 大樹、太田 泰広、大平 圭介、松村 英樹

15:45 16:05 Coffee break

セッション 20-2 座長：梅本 宏信 (静岡大学)

16:05 16:35 8. メッシュ状金属キャタライザを用いた GaN 結晶のエピタキシャル成長 【招待講演】

○安井 寛治 1、末光 眞希 2、遠藤 哲郎 2、伊藤 隆 3、中澤 日出樹 4、成田 克 5、高田 雅介 1、赤羽 正志 1、

安井 寛治 1 (1 長岡技術科学大学、2 東北大学電気通信研究所、3 東北大学学際科国際高等研究センター、

4 弘前大学大学院、5 山形大学) 【招待講演】

16:35 16:50 9. N₂ ガスをドーピング原料とした n 型ナノ結晶 3C-SiC 薄膜の開発

○星出 純希 1、田畑 彰守 1、北川 明彦 2、近藤 明弘 2 (1 名古屋大学大学院、2 岐阜大学大学院)

16:50 17:05 10. ホットワイヤーによる N₂ ガスの分解

○間崎 耕司 1、田畑 彰守 1、北川 明彦 2、近藤 明弘 2 (1 名古屋大学大学院、
2 岐阜大学大学院)

17:05 17:20 11. Hot-mesh CVD 法を用いた原料ガスパルス供給による GaN 成長

○小前 泰彰 1、斎藤 健 1、末光 眞希 2、遠藤 哲郎 2、伊藤 隆 3、中澤 日出樹
4、成田 克 5、高田 雅介 1、

赤羽 正志 1、安井 寛治 (1 長岡技術科学大学、2 東北大学電気通信研究所、
3 東北大学学際科国際高等研究センター、4 弘前大学大学院、5 山形大学)

17:20 18:30 バス移動

18:30 20:30 懇親会 (ロワジールホテル厚木)

6月21日(土)

開始 終了 講演題目、発表者 (○: 登壇者)、所属

セッション 21-1 座長: 部家 彰 (兵庫県立大学大学院)

9:10 9:40 12. 原子状水素を用いたレジスト除去 【招待講演】

○堀邊 英二 (金沢工業大学大学院)

9:40 9:55 13. 第三電極を有するマグネトロンスパッタ法により作製した ZnO 薄膜の低抵抗化
ー水素プラズマアニールの効果ー

○陸 鴻 1、片桐 裕則 2、神保 和夫 2、増田 淳 3、黒木 雄一郎 1、高田 雅介 1、赤
羽 正志 1、安井 寛治 1

(1 長岡技術科学大学大学院、2 長岡工業高等専門学校、3 産業技術総合研究所)

9:55 10:10 14. 原子状水素による EUV マスククリーニング

○穴澤 俊久 1、西山 泰史 1、老泉 博昭 1、西山 岩男 1、阿部 一樹 2、山脇 宏一 2、
和泉 亮 2

(1 株式会社 半導体先端テクノロジーズ、2 九州工業大学)

10:10 10:25 15. ラジカル窒化条件と TiN_x 膜の特性との関連

○武山 真弓 1、佐藤 勝 1、青柳 英二 2、野矢 厚 1

(1 北見工業大学、2 東北大学)

10:25 10:45 Coffee break

セッション 21-2 座長: 武山 真弓 (北見工業大学)

10:45 11:15 16. HW 技術の実装プロセスへの応用展開 【招待講演】

○和泉 亮、石原 政道 (九州工業大学)

11:15 11:30 17. HWCVD 法による SiCN 膜の均一堆積条件の検討

○生田 哲大 1、中西 洋行 1、門谷 豊 2、和泉 亮 1

(1 九州工業大学、2 東洋ステンレス研磨工業株式会社)

11:30 11:45 18. Cat-CVD SiN_x 膜と PEN 基板との界面特性

○部家 彰、佐藤 真彦、松尾 直人 (兵庫県立大学大学院)

- 11:45 12:00 19. PECVD 法と Cat-CVD 法により作製した薄膜トランジスタの特性比較
 ○西崎 昭吾、大平 圭介、松村 英樹 (北陸先端科学技術大学院大学)
- 12:00 13:10 昼休み
- セッション 21-3 座長：松村 英樹 (北陸先端科学技術大学院大学)
- 13:10 14:00 20. 日本の製造業の危機と再生 【特別講演】 【本講演のみ無料です】
 ○中村 久三 (株式会社アルバック会長)
- 14:00 14:05 参加登録者以外の人々の退室
- セッション 21-4 座長：安井 寛治 (長岡技術科学大学)
- 14:05 14:45 21. Cat-CVD 技術の現状と未来 【招待講演】
 ○松村 英樹、大平 圭介 (北陸先端科学技術大学院大学)
- 14:45 15:05 Coffee break
- セッション 21-4 座長：安井 寛治 (長岡技術科学大学)
- 15:05 15:35 22. Cat-CVD(Hot-wire CVD)技術を用いた薄膜 Si 太陽電池 【招待講演】
 ○野々村 修一 1、小川 俊輔 1、吉田 憲充 1、飯田 民夫 2
 (1 岐阜大学大学院、2 岐阜工業高等専門学校)
- 15:35 15:05 23. Cat-CVD(HW-CVD)法の結晶 Si 太陽電池への応用 【招待講演】
 ○宮島 晋介、山田 明、小長井 誠 (東京工業大学大学院)
- 16:05 16:20 24. Cat-CVD a-Si、SiNx 膜を用いた裏面電極型 a-Si/c-Si ヘテロ接合太陽電池の作製
 ○小山 晃一、大平 圭介、松村 英樹 (北陸先端科学技術大学院大学)
- 16:20 16:35 25. フラッシュランプ熱処理により形成した poly-Si 太陽電池の高圧水蒸気熱処理効果
 ○竹本 寛之、柴 和宏、藤原 友子、遠藤 洋平、西崎 昭吾、ジャン ヨン レ、
 大平 圭介
 西岡 賢祐、松村 英樹 (北陸先端科学技術大学院大学)
- 16:35 16:50 26. フラッシュランプアニールによる a-Si の結晶化における下地金属依存性
 ○柴 和宏、竹本 寛之、藤原 友子、遠藤 洋平、西崎 昭吾、ジャン ヨン レ、
 大平 圭介
 西岡 賢祐、松村 英樹 (北陸先端科学技術大学院大学)
- 16:50 17:05 27. Si、SiC でキャップされた Ge、SiC ナノドット構造の形成と光学特性の評価
 ○須藤 晴樹、黒田 朋義、加藤 有行、西山 洋、井上 泰宣、
 赤羽 正志、高田 雅介、安井 寛治 (長岡技術科学大学)
- 17:05 17:15 クロージング